DYFUZJA SIARKI ³⁵S W β-Ni₃S₂

Jolanta Gilewicz-Wolter*, Zbigniew Żurek** i Andrzej Ochoński*

^{*}Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków ^{**}Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

DIFFUSION OF SULFUR ³⁵S IN β-Ni₃S₂

Summary

The diffusion of ³⁵S radioisotope in β -Ni₃S₂ polycrystals was studied at temperatures ranging from 848 K to 893 K and at sulfur vapor pressure interval (5.610⁻⁶ \div 3.210⁻⁴) Pa. The autoradiography and the tracer sectioning method were used. It was found, that the bulk diffusion is the main process of sulfur transport. The activation energy of the diffusion equals (190±10) kJ mol⁻¹. Under the conditions used in the experiments the dominant anionic point defects are single-ionized vacancies and quasifree electrons.

Streszczenie

Przeprowadzono badania dyfuzji ³⁵S w polikrystalicznych próbkach β-Ni₃S₂ w zakresie ciśnienia par siarki (5.6 10⁻⁶ ÷ 3.2 10⁻⁴) Pa oraz temperatury (848 ÷ 893) K. W badaniach stosowano technikę autoradiografii oraz zbierania warstw. Stwierdzono, że głównym procesem transportu siarki jest dyfuzja sieciowa. Wyznaczona energia aktywacji dyfuzji jest równa (190±10) kJ mol⁻¹. Stwierdzono również, że w warunkach doświadczeń dominującymi defektami punktowymi podsieci anionowej β-Ni₃S₂ są jednowartościowe wakancje i quasi-swobodne elektrony.

Wstęp

 β -Ni₃S₂ jest wysokotemperaturową postacią Ni₃S₂, krystalizującą w układzie heksagonalnym. Siarczek ten wykazuje silne zdefektowanie w podsieci kationowej [1-5]. Współczynniki dyfuzji niklu w tym siarczku, obliczone na podstawie wyników badań kinetyki wzrostu warstwy siarczku [5] oraz zmierzone metodą atomów znaczonych [6] są bardzo wysokie i wskazują na dużą ruchliwość defektów punktowych podsieci kationowej.

W oparciu o wyniki pomiarów termograwimetrycznych, rentgenowskich oraz pomiarów gęstości stwierdzono, że β -Ni₃S₂ jest również zdefektowany w podsieci anionowej [3]. W siarczku tym mogą występować równocześnie wakancje kationowe i aniony międzywęzłowe, lub wakancje anionowe i międzywęzłowe kationy. Tak więc wzór stechiometryczny siarczku przyjmuje postać: Ni_{3±y}S_{2±x}. Maksymalne wartości odstępstw od składu stechiometrycznego są równe: w równowadze z metalem y = 0,25, x = -0,16, a w równowadze z NiS y = -0,3, x = 0,15

Metodyka badań

<u>Otrzymywanie próbek β -Ni₃S₂. β -Ni₃S₂ otrzymywano droga siarkowania płytek spektralnie czystego niklu (produkcji firmy Johnson & Matthey) w mieszninie H₂S/H₂ w temperaturze 863 K. Ciśnienie par siarki wynosiło 3,2 ·10⁻⁴ Pa. Siarkowanie prowadzono w aparaturze opisanej w pracy [7]. Proces prowadzono aż do zupełnego</u>

przereagowania niklu, a następnie wygrzewano próbki przez 10 dni w takim ciśnieniu par siarki i temperaturze, w jakich były prowadzone późniejsze badania dyfuzji. To wstępne wygrzewanie próbek przeprowadzono celem uniknięcia gradientu stężenia defektów punktowych w próbce. Skład fazowy siarczku był kontrolowany metodą rentgenograficznej analizy fazowej. Z tak przygotowanych siarczków wycinano próbki o grubości 0,12 cm i powierzchni ok. 1 cm². Powierzchnie próbek były szlifowane tak, aby uzyskać próbki o kształcie prostopadłościanów, a następnie polerowane i odtłuszczane acetonem. Średnice ziarn β -Ni₃S₂ zawierały się w przedziale (0,1-1,2) mm.

<u>Wygrzewanie dyfuzyjne</u>. Wygrzewanie dyfuzyjne próbek prowadzono w ampułach kwarcowych w ściśle określonym ciśnieniu par siarki i temperaturze. W jednym końcu ampuły umieszczano próbkę β -Ni₃S₂, a w drugim mieszaninę sproszkowanych siarczków miedzi Cu₂S/CuS znaczonych promieniotwórczym izotopem siarki ³⁵S. Mieszanina ta była źródłem par siarki w czasie wygrzewania dyfuzyjnego. Aktywność właściwa mieszaniny wynosiła 600 MBq/g. ³⁵S jest izotopem β -promieniotwórczym o maksymalnej energii cząstek β E = 167 keV i cząsie połowicznego rozpadu T_{1/2} = 87 dni.

Ampuły kwarcowe zawierające próbki β -Ni₃S₂ oraz mieszaninę Cu₂S/CuS były kilkakrotnie płukane helem i odpompowane celem usunięcia zaadsorbowanego tlenu, a następnie zamykane pod próżnią. Wygrzewanie dyfuzyjne prowadzono w taki sposób, że koniec ampuły zawierający próbkę siarczku β -Ni₃S₂ znajdował się w wyższej temperaturze, natomiast drugi koniec, zawierający mieszaninę siarczków miedzi, w temperaturze niższej. Do pomiaru temperatury próbki, jak również mieszaniny Cu₂S/CuS używano termopar Pt-Pt10%Rh. Wewnątrz ampuły panowało ciśnienie par siarki ustalone przez równowagę reakcji:

$$2 \text{ CuS} = \text{Cu}_2\text{S} + 1/2 \text{ S}_2 \tag{1}$$

w określonej temperaturze. Według dostępnych danych termochemicznych [8] i przy założeniu, że pary siarki o niskim ciśnieniu można traktować jak gaz doskonały, ciśnienie par siarki w ampułach zawierało się w granicach $(5,6 \cdot 10^{-6} - 3,2 \cdot 10^{-4})$ Pa. Po zakończeniu wygrzewania dyfuzyjnego ampuły gwałtownie schładzano.

<u>Wyznaczanie profili dyfuzyjnych</u>. Rozkład promieniotwórczego izotopu siarki w przekroju wygrzanej próbki wyznaczano dwoma metodami:

- 1. metodą fotometrowania autoradiogramów poprzecznych przekrojów wygrzewanych próbek
- 2. metodą analizy warstwowej.

ad 1. Celem otrzymania autoradiogramów próbki umieszczano w żywicy poliakrylowej, po polimeryzacji której przecinano prostopadle do ich powierzchni i wykonywano zgłady metalograficzne. Tak przygotowane próbki stawiano na błonie fotograficznej typu TN-12 produkcji Foton, Warszawa. Zaczernienie otrzymanych autoradiogramów oznaczano przy użyciu mikrofotometru IFO-451 sprzężonego z komputerem. ad 2. Metoda analizy warstwowej polega na kolejnym zdejmowaniu z próbek cienkich równoległych warstw, prostopadłych do kierunku dyfuzji. W warstwach tych, lub w próbce pozostałej po zdjęciu kolejnej warstwy, oznacza się stężenie dyfundującego pierwiastka. W omawianych doświadczeniach warstwy zdejmowano mechanicznie drogą szlifowania próbek. Po zakończeniu wygrzewania dyfuzyjnego obcinano brzegi próbek, aby w pomiarach uniknąć wpływu aktywności pochodzącej od krawędzi próbek [9]. Próbka przeznaczona do ścierania była umieszczona w żywicy poliacrylowej wraz z trzema stalowymi kulkami o promieniu (2,494 \pm 0.002) mm. Kulki były ścierane wraz z próbką. Na podstawie znajomości średnicy kulek obliczano grubość zdjętej warstwy. Średnice kulek mierzono przy pomocy komparatora Abbe'go sprzężonego z kamerą TV i monitorem. Ponieważ w tej metodzie zdejmowania warstw niemożliwy jest ilościowy pomiar stężenia izotopu w zdjętej warstwie, wybrano metodę pomiaru stężenia w próbce pozostałej po zdjęciu kolejnej warstwy. Pomiary częstości zliczeń wykonano licznikiem Geigera-Müllera z cienkim okienkiem mikowym. Błąd statystyczny pomiarów nie przekraczał 1%.

Ponieważ doświadczenia były prowadzone w taki sposób, że warunki rozwiązania II prawa Fick'a dla cienkiego żródła dyfuzji i układu półnieskończonego były spełnione, zastosowano rozwiązanie tego równania dla wybranego wariantu analizy warstwowej [9,10]. Jeśli I jest częstością zliczeń pochodzącą od próbki pozostałej po zdjęciu kolejnej warstwy, to

$$\ln\left(\frac{\partial I}{\partial x} - \mu I\right) = const - \frac{x^2}{4Dt}$$
(2)

gdzie μ - liniowy współczynnik pochłaniania w materiale próbki, x - odległość od powierzchni próbki, D - współczynnik dyfuzji objętościowej, t - czas wygrzewania dyfuzyjnego.

Równanie (2) ma ogólny charakter. Dla przedstawianych badań, gdy izotop emituje cząstki β^{-} o niskiej energii, a więc współczynnik absorpcji jest bardzo duży, równanie przyjmuje postać:

Wyniki badań

$$1.00 - 1.00 -$$

8.00

10⁴·x² [cm²]

 $\ln I = const - \frac{x^2}{4Dt}$

β-Ni₃S₂ jest dyfuzja sieciowa. Na autoradiogramach płaszczyzn próbek, prostopadłych do kierunku dyfuzji, nie znaleziono obrazu granic ziarn próbek oznacza to, że w warunkach eksperymentów udział dyfuzji wzdłuż granic ziarn był niewielki. Na rys. 1 przedstawiono przykładowe profile dyfuzji uzyskane metodą analizy warstwowej (1) i fotometrycznie (2). Wyliczone współczynniki dyfuzji mają niskie wartości, o kilka rzędów wielkości niższe niż współczynniki dyfuzji niklu w tym siarczku [4-6].

(3)



4.00

0.00

12.00









Przy porównywalnych odstępstwach od składu stechiometrycznego w podsieci kationowej i anionowej, świadczy to o znacznie mniejszej ruchliwości defektow podsieci anionowej niż kationowej.

Rys. 2 przedstawia zależność współczynnika dyfuzji ³⁵S od temperatury w układzie Arrheniusa. Obliczona energia aktywacji wynosi (190 \pm 10) kJ/mol. Zależność współczynnika dyfuzji D* od ciśnienia par siarki została przedstawiona na rys. 3.

Dyskusja wyników

Na rys. 4 przedstawiono fragment diagramu fazowego układu Ni - S, obejmujący obszar trwałości β -Ni₃S₂. Dane termochemiczne dotyczące tego układu różnią się, niekiedy znacznie, między sobą. Do sporządzenia diagramu wykorzystano, jako zgodne, dane z prac [1,11]. Na diagramie zaznaczono punkty obrazujące parametry, w których wykonano badania dyfuzji ³⁵S. Warunki badań dyfuzji zostały tak dobrane, by w myśl ich przewidywań β -Ni_{3±y}S_{2±x}. był półprzewodnikiem typu n, a dominującymi defektami punktowymi podsieci anionowej były wakancje i quasi-swobodne elektrony. Powstawanie wakancji anionowych można opisać równaniem [12,13]:

$$S_s = V_s + 1/2 S_2$$
 (4)

W odpowiednio wysokiej temperaturze wakancja może ulegać jonizacji:

$$V = V_S + e^{-1}$$
(5)

$$\mathbf{V}^{'} = \mathbf{V}_{\mathbf{S}}^{''} + \mathbf{e}^{\mathbf{T}} \tag{6}$$

Stosując prawo działania mas do równowag $(4) \div (6)$ oraz uproszczony warunek elektroobojętności sieci:

$$[e^{-}] = [V_{S}] + 2 [V_{S}]$$
(7)



Rys. 4. Diagram fazowy β -Ni₃S₂. Punkty na diagramie odwzorowują parametry, w jakich zostały wykonane badania.

otrzymuje się zależność stężenia wakancji od ciśnienia par siarki. Gdy $[V_S] >> [V_S]$,

$$[V_S] = \operatorname{const} \cdot p(S)_2^{-1/4} \tag{8}$$

natomiast gdy $[V_S] \ll [V_S]$

$$[V_S] = \operatorname{const} \cdot p(S)_2^{-1/6} \tag{9}$$

Jak widać na rys. 3, w zakresie ciśnień par siarki $(3,2 \cdot 10^{-5} \div 3,2 \cdot 10^{-4})$ Pa w temperaturze 893 K, zależność log D* od log (pS₂) jest liniowa. Świadczy to o małym wzajemnym oddziaływaniu defektów podsieci anionowej. Współczynnik kierunkowy prostej jest w przybliżeniu równy -1/4. Ta wartość współczynnika kierunkowego, zgodnie z równaniem (8) wskazuje, że w warunkach eksperymentów dominującymi defektami punktowymi podsieci anionowej są pojedynczo naładowane wakancje i quasi swobodne elektrony.

W oparciu o przedstawione wyniki badań, współczynnik dyfuzji ³⁵S w β -Ni_{3±y}S_{2±x} w zakresie temperatury (860 ÷ 893) K i ciśnienia par siarki (5,6 ·10⁻⁶ ÷ 3,2 ·10⁻⁴) Pa można opisać równaniem:

$$D^{*}[cm^{2} \cdot s^{-1}] = 1,057 \cdot p(S_{2})^{-1/4} \cdot \exp\left(-\frac{190000}{RT}\right)$$
(10)

Współczynnik dyfuzji znacznika D*, jest powiązany ze współczynnikiem dyfuzji własnej równaniem [12]:

$$D = \frac{D^*}{f} \tag{11}$$

Jeżeli mechanizm dyfuzji, a tym samym współczynnik korelacji f byłby znany, znajomość współczynnika dyfuzji znacznika D* umożliwiłaby obliczenie współczynnika dyfuzji własnej.

Wnioski

- 1. Głównym procesem transportu siarki w β-Ni_{3±y}S_{2±x} w warunkach eksperymentów jest dyfuzja sieciowa.
- 2. Wyniki badań dyfuzji promieniotwórczego izotopu siarki w β -Ni_{3±y}S_{2±x} potwierdziły, że podsieć anionowa tego siarczku wykazuje zdefektowanie.
- W zakresie temperatury (860 ÷ 893) K i ciśnień par siarki (5,6 ·10⁻⁶ ÷ 3,2 ·10⁻⁴) Pa dominującymi defektami punktowymi podsieci anionowej tego siarczku są wakancje i quasi-swobodne elektrony.
- Współczynnik dyfuzji siarki w β-Ni_{3±y}S_{2±x} jest kilka rzędów wielkości niższy niż współczynnik dyfuzji niklu w tym związku. Wskazuje to na znacznie mniejszą ruchliwość defektów podsieci anionowej niż kationowej.

Literatura

- [1]. Lin R. Y., Hu C. and Chang Y. A., Metal. Trans. <u>9B</u>, 531 (1984)
- [2]. Mrowec S., Przybylski K., High-Temp. Materials and Processes 6, 1 (1984)
- [3]. Stokłosa A. and Stringer J., Oxid. Met. <u>11</u>, 277 (1977)
- [4]. Stokłosa A., Dyfuzja chemiczna w tlenkach i siarczkach metali przejściowych, Zeszyty Naukowe A.G.H., Ceramika, z. 46. Kraków 1982
- [5]. Stokłosa A., Bartkowicz I., Solid State Ionics <u>12</u>, (1984)
- [6]. Gilewicz-Wolter J.and Żurek Z., Solid State Communications <u>88</u>, No. 4, 279 (1993)
- [7]. Żurek Z., J. Thermal. Anal. <u>39</u>, 15 (1993)
- [8]. Barin J. and Knacke O., Thermochemical Properties of Inorganic Substances and Suppl., Springer Ver. Berlin (1977)
- [9]. Rothman S. J., The Measurement of Tracer Diffusion Coefficients in Solids w Diffusion in Crystalline Solids, str. 1, wyd. Murch G.E. and Nowick A. S., Academic Press (1984)
- [10]. Atomic Diffusion in Semiconductors, wyd. Show D., Plenum Press London and New York (1973)
- [11]. Rosenquist T., Iron Steel J. Inst. <u>176</u>, 45 (1954)
- [12]. Mrowec S., Defect and Diffusion in Solids, Elsevier, Amsterdam (1980)
- [13]. Kröger A., The Chemistry of Imperfect Crystals, Elsevier, Amsterdam (1974)